电阻热蒸发镀膜与电子束蒸发镀膜对纳米球刻蚀 方法制备二维银纳米阵列结构的影响^{*}

罗银燕 朱贤方*

(厦门大学物理系,厦门 361005) (2010 年 8 月 16 日收到;2011 年 2 月 25 日收到修改稿)

在使用纳米球刻蚀法制备二维银纳米点阵的过程中,使用不同的镀膜方法在同样的模板上得到了不同形貌的 银纳米阵列结构.使用电阻热蒸发镀膜方法获得了六角排列的银纳米三角形阵列结构,使用电子束蒸发镀膜方法 则获得了六角排列的银纳米环阵列结构.研究表明,沉积纳米粒子的粒径、表面纳米曲率效应和热能是形成不同结 构形貌的纳米阵列结构的关键因素.

关键词:银纳米阵列,电阻热蒸发,电子束蒸发,纳米球刻蚀 PACS: 61.46. Df, 81.15.-z, 81.16. Nd

1. 引 言

纳米金属粒子具有特殊的光学性质^{[1→1},其在 生物和化学传感器^[5-7]、表面增强光谱技术^[8,9]等 方面有着广阔的应用前景.因此,近年来人们在纳 米结构的制备方面进行了大量的实验.目前制备有 序纳米阵列结构的方法常见的有电子束光刻^[10-12] 和纳米球刻蚀^[13-16]方法.相比较而言,电子束光刻 制备的纳米阵列结构形状规则、缺陷少,但是对设 备要求较高、成本昂贵,且不能大面积制备;而纳米 球刻蚀由于成本低廉,且可以获得较大面积的纳米 有序阵列结构而被广泛采用.

在通过纳米球刻蚀获得银纳米阵列结构的过 程中,本文选用电阻热蒸发镀膜和电子束蒸发镀膜 两种蒸发镀膜方法来进行比较.实验发现:不同的 蒸发镀膜方法得到的二维银纳米阵列结构具有不 同的形貌.电阻热蒸发方法获得了六角排列的三角 形阵列结构,而电子束蒸发方法获得了六角形排列 的纳米环阵列结构.我们对相应结构的形貌进行了 观测、表征和分析,并对不同纳米阵列结构形成的 机制进行了探讨.

2. 实 验

2.1. 基片处理

在自组装过程中,获得的聚苯乙烯纳米球六角 密排结构主要是通过毛细作用力,使纳米球在基片 上自由地扩散进而达到最低自由能的结构.因此, 为了得到面积相对较大的单层结构,必须保证基底 表面平整、洁净且化学特性相同.所以,对基片的清 洗至关重要.为了去除基片表面上的杂质离子,我 们采用了如下的清洗过程:首先,将玻片依次在甲 苯、丙酮、乙醇三种溶剂中分别超声清洗 10 min,然 后用大量去离子水清洗干净,并用氮气吹干,以去 除玻片表面的有机物.接着,将玻片在浓硫酸和双 氧水(浓度为30%)的混合液(体积比为3:1)中煮1 h,温度为80℃,然后用去离子水冲洗干净,用以清 除玻片表面的金属杂质. 最后. 为了使玻片表面化 学特性相同,我们将玻片在去离子水、双氧水和氨 水(浓度为28%)的混合液(体积比为5:1:1)中煮 10 min,然后用大量去离子水冲洗干净,并将清洗后 的玻片保存在去离子水中(不超过三天),使用时用

*科学技术部国际科技合作计划(批准号:2008DFA51230)、国家重点基础研究发展计划(批准号:2007CB936603)和国家自然科学基金 (批准号:60776007,11074207)资助的课题.

©2011 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†]通讯联系人. E-mail: zhux@ xmu. edu. cn

氮气吹干.

2.2. 纳米球刻蚀

利用滴涂的方法在玻璃基片上制备出单层密 排的聚苯乙烯纳米球模板.首先将清洗好的玻片以 一定的角度(3°-5°)倾斜放置,并将预先稀释好 的聚苯乙烯纳米球胶体(直径为(340±10) nm,质 量比为1%,实验室自制)滴在玻片上,然后将玻片 在恒温(35℃)恒湿(相对湿度为46%)的环境中 晾干.所形成的单层六角密排的区域在玻片上大部 分呈长条形分布,最大密排面积可达 400 μm × 800 μm. 在制好的聚苯乙烯纳米球模板上分别利用电阻 热蒸发(银粒纯度为 99.99%, 真空度为 5.0 × 10⁻⁴ Pa, 沉积速率为2.5 nm/s) 方法和电子束蒸发(银粒 纯度为 99.99%, 真空度为 5.0 × 10⁻⁴ Pa, 沉积速率 为 0. 27 nm/s) 方法沉积一层厚度约为 100 nm 的银 膜.最后将沉积有银膜的聚苯乙烯纳米球玻璃衬底 在乙醇溶液中超声清洗1 min,移除聚苯乙稀纳米 球,得到规则排列的银纳米点阵结构.

3. 结果及讨论

图 1 为利用两种不同沉积方法沉积银膜后的聚 苯乙烯纳米球的扫描电子显微镜(SEM)图像.从图 1(a)可以看出:电阻热蒸发所得到的沉积粒子的粒 径较为均匀,半径约为10 nm,聚苯乙烯纳米球表面 的银层较为平整.聚苯乙烯纳米球之间的三角形空 隙虽被沉积粒子填充,但未被完全充满,空隙仍然 清晰可见.聚苯乙烯纳米球表面无明显的变化,并 与其周围的银纳米粒子共同形成界面能最小的正 六边形结构. 而从图 1(b) 可以看出: 电子束蒸发得 到的沉积粒子的粒径明显大于电阻热蒸发方法得 到的沉积粒子的粒径,其半径为20-25 nm. 聚苯乙 烯纳米球表面的银层较为粗糙,沉积粒子间相互熔 合在一起.聚苯乙烯纳米球表面出现一定程度的形 变,并与沉积粒子有所熔合.此外,聚苯乙烯纳米球 之间的三角形空隙在沉积银层后没有缩小,与未沉 积前相比略有增大,而聚苯乙烯纳米球半径比未沉 积银层前则略有减少.

从上述实验现象可知,利用电阻热蒸发方法与 电子束蒸发方法在单层排列的聚苯乙烯纳米球基 片上得到的银层存在着明显的结构差异.主要原因 可能是不同的沉积方法得到的沉积粒子粒径的不



图 1 利用两种不同方法沉积银膜后形成不同形貌的单层密排 聚苯乙烯纳米球阵列 内插图为沉积银层后的聚苯乙烯纳米球 照片.(a)电阻热蒸发沉积方法,(b)电子束蒸发沉积方法

同与其热容量的差异. 在沉积过程中,由于电阻热 蒸发方法形成的沉积粒子粒径较小,单个粒子热容 量也较小,但沉积粒子密度较大,因此聚苯乙烯纳 米球表面的银层能量分布较为均匀,最终形成的银 层较为平整.同时,由于沉积粒子的粒径小,纳米曲 率大,表面能较高,在成膜过程中易诱导金属原子 扩散,快速达到平衡,与聚苯乙烯纳米球一起形成 界面能最小的正六边形结构,如图1(a)所示.而在 电子束沉积过程中,由于沉积粒子的粒径较大,密 度小,单个粒子热容量很高,使聚苯乙烯纳米球表 面熔化变形.同时,由于沉积粒子密度小,导致其传 递给聚苯乙烯纳米球表面的热能分布不平衡,进而 在聚苯乙烯纳米球表面形成如图1(b)所示较粗糙 的银层. 而聚苯乙烯纳米球间的三角形空隙则由聚 苯乙烯纳米球与沉积粒子局部熔合收缩,致使三角 形空隙略显增大.

图 2 是移除聚苯乙烯纳米球后获得的二维银纳 米阵列结构图像.图 2(a)和(c)是利用电阻热蒸发 方法获得的三角形银纳米阵列结构.由图 2(a)和 (c)可以看到,银纳米粒子在玻片上呈规则的三角



图 2 银纳米阵列结构 (a)利用电阻热蒸发方法得到的六 角排列的三角形银纳米阵列结构的 SEM 图像,(b)利用电子 束蒸发方法得到的六角排列的银纳米环阵列结构的 SEM 图 像,(c)三角形银纳米阵列结构的原子力显微镜图像,(d)银 纳米环阵列结构的原子力显微镜图像

形,且三角形表面平整,无明显的颗粒,并在整体上 呈六角形点阵排列.图3(a)为六角形排列的三角形 银纳米阵列结构示意图, D_t 为三角形银纳米粒子组 成的六角阵列单元结构内的无银区域的特征尺寸, 从图2(a)测得 $D_t \approx 130$ nm.图2(b)和(d)是应用 电子束蒸发方法获得的银纳米环阵列结构,图中的 银纳米粒子在玻片上形成环状的纳米结构,每一个 纳米环均由半径约为20 nm 的多个银纳米粒子构 成,纳米环在整体上呈六角点阵排列.图3(b)为六 角形排列的银纳米环阵列结构示意图, D_e 为银纳米 环组成的六角阵列单元结构内的无银区域的特征 尺寸,由图2(b)测得 $D_e \approx 105$ nm.



图 3 银纳米阵列结构示意图 (a)利用电阻热蒸发方法得到的三角形银纳米阵列结构,(b)利用电子束蒸发方法得到的银纳米环阵列结构

图 2 中不同的银纳米阵列结构可以分别由图 4 和图 5 来进行解释. 假定与聚苯乙烯纳米球间的三 角形空隙相切的圆的半径(即在膜沉积过程中可以 通过聚苯乙烯纳米球间的三角形空隙的最大沉积 粒子的半径)为 r₁,聚苯乙烯纳米球半径为 R. 从图 4 可知,当沉积粒子的半径小于 r₁ 时可以进入聚苯 乙烯纳米球之间的三角形空隙. r₁ 与聚苯乙烯纳米 球半径 R 应满足

$$r_1 = (2\sqrt{3}/3 - 1)R. \tag{1}$$

此处聚苯乙烯纳米球半径 R = 170 nm. 利用(1)式计算可得, $r_1 = 26$ nm. 电阻热蒸发方法得到的沉积粒

子半径较小(约为10 nm),远小于 r₁(26 nm), 很容易通过聚苯乙烯纳米球间的空隙到达基底. 电子束蒸发方法得到的沉积粒子半径虽然较大 (20—25 nm),但仍小于 r₁(26 nm),可以通过聚苯 乙烯纳米球间的空隙到达基底.而沉积粒子在通过 聚苯乙烯纳米球间的空隙到达基底后,由于具有较 高的温度和正曲率成为"热"纳米球,而聚苯乙烯纳 米球与基底的空隙则由于具有较低的室温和负曲 率成为"冷"纳米阱,在温度和纳米曲率效应^[17,18] 的影响下,高低温度和正负曲率相互吸引,作为 "热"的沉积粒子向作为"冷"的聚苯乙烯纳米球与 基底的空隙运动,如图5 所示.



图 4 聚苯乙烯纳米球间隙结构示意图



图 5 沉积粒子运动示意图

由图 5 可知,在沉积过程中,假定沉积粒子半径为r,沉积粒子移动到与聚苯乙烯纳米球接触时距 离为 d,沉积粒子可以到达的最远距离为 D_e(即到 达聚苯乙烯纳米球边缘处),则 d 满足

$$d = R + r_1 - r - D_c$$

= R + (2 \sqrt{3}/3 - 1)R - r - (\sqrt{4Rr} - r)
= 2 \sqrt{3}R/3 - \sqrt{4Rr}. (2)

在电阻热蒸发沉积过程中, $r \approx 10$ nm. 由(2)式 推算可知, $d \approx 113.8$ nm. 而我们在实验中测得的沉 积粒子移动距离($R + r_1 - r - D_1$)为 56 nm,明显小 于所推测的距离.这说明沉积粒子在未与聚苯乙烯 纳米球接触前已停止运动.发生这种现象可能的主 要原因如下:在电阻热蒸发沉积过程中,由于沉积 速率较快(2.5 nm/s),沉积粒子的密度较大,同一 时间内有大量的粒子到达基底,且由于粒子粒径较 小,表面能较高,粒子不稳定,同时由于粒子表面温 度较高,粒子间碰撞后容易熔合在一起.这使得单 个沉积粒子自由运动的时间较短,在未运动到与聚 苯乙烯纳米球相接触前就已与其他粒子熔合在一 起,进而被迫停止在基底表面,这大大减小了沉积 粒子在基底上的运动距离.因此,沉积粒子实际的 运动位移小于理论计算值.在移去聚苯乙烯纳米球 后,形成了如图2(a)、图3(a)所示较为完整的三角 形六角点阵.

在电子束热蒸发沉积过程中,r为20-25 nm. 同理,利用(2)式可求出 d 为 65.9—73.7 nm. 而我 们实验测得的沉积粒子实际移动距离(R+r₁-r-D_e)为66-71 nm,与推测得出的理论值(65.9-73.7 nm 基本一致. 这主要可能是由于在沉积过程 中,电子束蒸发方法沉积粒子密度较小,沉积速率 较慢(0.27 nm/s).因此,同一时间内落到基底上的 沉积粒子数量较少,粒子间不易发生相互接触和融 合,有充分的时间运动,进而可以到达如图5所示最 远的与聚苯乙烯纳米球相接触位置.同时,由于沉 积粒子半径较大(20-25 nm),所以沉积厚度约为 100 nm 银层的沉积粒子数量有限,聚苯乙烯纳米 球间的空隙中心处的沉积粒子几乎都能运动到与 聚苯乙烯纳米球相接触的位置,这样中心位置由于 无沉积粒子,进而形成空的无银区,最终在聚苯乙 烯纳米球下方形成如图 2(b) 及图 3(b) 所示的环状 结构.

4. 结 论

本文使用纳米球刻蚀的方法,利用聚苯乙烯纳 米球作为模板,分别采用电阻热蒸发和电子束蒸发 两种不同的镀膜方法,在玻璃基片上制备出了两种 截然不同的银纳米阵列结构.电阻热蒸发方法得到 了六角排列的三角形银纳米阵列结构,而电子束蒸 发方法得到了六角排列的银纳米粒子环阵列结构. 形成不同银阵列结构的主要原因可能是因为电阻 热蒸发过程中得到的沉积粒子粒径较小,沉积速率 较快,到达基底后容易发生碰撞熔合,使得单个沉 积粒子自由运动距离较短,进而形成了三角形银纳 米阵列结构.而在电子束蒸发过程中得到的沉积粒 子粒径较大,沉积速率较慢,到达基底后不易发生 碰撞,单个沉积粒子自由运动距离较长,最终形成 了银纳米环阵列结构.

感谢黄胜利博士和黄娆博士就本文工作进行的讨论和 提出修改意见.

- [1] Ayad M M, Prastomo N, Matsuda A, Stejskal J 2010 Synth. Met. 160 42
- [2] Zhu S L, Du C L, Fu Y Q 2009 Opt. Mater. 31 769
- [3] Wang G, Duan M Y, Cui Y P, Zhang Y, Liu M 2005 Acta Phys. Sin. 54 144 (in Chinese) [王 刚、端木云、崔一平、 张 宇、刘 宓 2005 物理学报 54 144]
- [4] Zhu B H, Wang F F, Zhang K, Ma G H, Gu Y Z, Guo L J, Qian S X 2008 Acta Phys. Sin. 57 3058 (in Chinese) [朱宝 华、王芳芳、张 琨、马国宏、顾玉宗、郭立俊、钱士雄 2008 物 理学报 57 3085]
- [5] Endo T, Yamamura S, Kerman K, Tamiya E 2008 Anal. Chim. Acta 614 182
- [6] Bai Y, Yang H, Yang W W, Y C, Sun C Q 2007 Sensor Actuat.
 B 124 179
- [7] Yonzon C R, Stuart D A, Zhang X Y, McFarland A D, Haynes C L, Van Duyne R P 2005 *Talanta* 67 438
- [8] Sanci R, Volkan M 2009 Sensor Actuat. B 139 150
- [9] Zhu X, Yang H F, Wang N, Zhang R, Song W, Sun Y P, Duan G P, Ding W, Zhang Z G 2010 J. Colloid Interf. Sci. 342

571

- [10] DeRose G A, Zhu L, Poon J K S, Yariv A, Scherer A 2008 Microelectron. Eng. 85 758
- [11] Barbillon G, Bijeon J L, Plain J, Lamy de la Chapelle M, Adam P M, Royer P 2007 Surf. Sci. 601 5057
- [12] Stodolka J, Nau D, Frommberger M, Zanke C, Giessen H, Quandt E 2005 Microelectron. Eng. 78 442
- [13] Sun P, Xu L, Zhao W M, Li W, Xu J, Ma Z Y, Wu L C, Huang X F, Chen K J 2008 Acta Phys. Sin. 57 1951 (in Chinese) [孙 萍、徐 岭、赵伟明、李 卫、徐 骏、马忠 元、吴良才、黄信凡、陈坤基 2008 物理学报 57 1951]
- [14] Wang K, Yang G, Long H, Li Y H, Dai N L, Lu P X 2008
 Acta Phys. Sin. 57 3862 (in Chinese) [王 凯、杨 光、龙 华、李玉华、戴能利、陆培祥 2008 物理学报 57 3862]
- [15] Canpean V, Astilean S, Petrisor T Jr, Gabor M, Ciascai I 2009 Mater. Lett. 63 1834
- [16] Li W, Zhao W M, Sun P 2009 Physica E 41 1600
- [17] Zhu X F, Wang Z G 2006 Int. J. Nanotechnol. 3 492
- [18] Zhu X F 2003 J. Phys. : Condens. Matter 15 253

Effects of thermal evaporation and electron beam evaporation on two-dimensional patterned Ag nanostructure during nanosphere lithography*

Luo Yin-Yan Zhu Xian-Fang[†] (Department of Physics, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

(Received 16 August 2010; revised manuscript received 25 February 2011)

Abstract

In the process of fabricating two-dimensional Ag nano-arrays via nanosphere lithography, different deposition methods present different lattice point shapes of Ag nanostructure. Nano-triangles are produced by thermal evaporation whereas nano-rings are obtained by electron beam evaporation although they are both of hexagonal lattice. It is indicated that the sizes, the surface nanocurvature, the thermal and the kinetic energies of the particles deposited are key factors controlling the formation of the shape of Ag lattice point.

Keywords: Ag nano-arrays, thermal evaporation, electron beam evaporation, nanosphere lithography PACS: 61.46. Df, 81.15.-z, 81.16. Nd

^{*} Project supported by the International Science and Technology Cooperation Program of Ministry of Science and Technology, China (Grant No. 2008DFA51230), the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2007CB936603) and the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 60776007, 11074207).

[†] Corresponding author. E-mail: zhux@ xmu. edu. cn